

77848

36

整理番号: EP-0233701 発送番号: 014074 発送日: 平成16年 1月20日 1

(77845)

## 拒絶理由通知書



特許出願の番号 特願2000-102083  
 起案日 平成16年 1月15日  
 特許庁審査官 小川 将之 9634 4M00  
 特許出願人代理人 井上 一 (外 2名) 様  
 適用条文 第29条第1項、第29条第2項

F005746

4500 4500

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

・請求項1-3, 12-16, 28-34

理由2

引用例1-2

<備考>

引用例1には、不揮発性メモリトランジスタとアナログキャパシタを備えた半導体装置が記載されている。アナログ処理を行う半導体装置を構成するため特性の異なる複数の容量素子を形成することは、例えば引用例2 (【0002】～【0004】及び第5図参照) に記載されている。

・請求項51, 53-55, 67-68

理由1, 2

引用例1

<備 考>

引用例1の実施例3及び第13～20図を特に参照。

・請求項51, 53-59, 62-75, 77-82

理由2

引用例1, 3-4

<備 考>

引用例3(【0023】～【0033】及び第2～14図)の半導体装置は、誘電体膜及び中間絶縁膜の点で本願と相違するが、下部電極から上部電極へ向かって、順に、第1酸化膜、第2酸化膜、窒化膜、第3酸化膜を有する構造の誘電体膜(ONONO膜)、及び、フローティングゲートからコントロールゲートへ向かって、順に、第1酸化膜、第2酸化膜、第3酸化膜を有する構造の中間絶縁膜(ONONON膜)は、ともに引用例1に記載されている公知の事項である。また、フローティングゲート上に選択酸化膜を形成する点については、引用例4に記載されている。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項4-11, 17-27, 35-50, 52, 60-61, 76に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平5-21808号公報
2. 特開平9-321227号公報
3. 特開平9-92736号公報
4. 特開平10-154792号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版

H01L29/788

H01L21/8229

H01L21/8239-21/8247

H01L27/10-27/115

・先行技術文献

特開平3-105981号公報

特開平4-348568号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

-----  
この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部半導体機器 小川 将之（おがわ まさゆき）

TEL. 03 (3581) 1101 内線3462

FAX. 03 (3501) 0673